This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
 - TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
 - FADED TEXT
 - ILLEGIBLE TEXT
 - SKEWED/SLANTED IMAGES
 - COLORED PHOTOS
 - BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
 - GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Problem Image Mailbox.

Partial English Translation of

Publication No. 63-010603A for UM

From line 8 on page 7 to line 7 on page 8

First, as dielectric materials of which polarities of a temperature characteristic of a resonance frequency are different from each other, a PbZrO₃-CeO₂ dielectric material and a SrTiO₃-NiO-Nb₂O₅ dielectric material are employed and are respectively used as a dielectric material (1) and a dielectric material (2) to prepare the same dielectric resonator as that shown in Figure 1. The characteristics of the employed dielectric materials at 3GHz will be hereinafter indicated:

A: PbZrO₃-CeO₂ dielectric material

Dielectric Constant ε_r 139

Nonloaded Q 700

Temperature Coefficient of Resonance Frequency τ_f -1070 (ppm/°C)

B: SrTiO₃-NiO-Nb₂O₅ dielectric material

Dielectric Constant ε_r 213

Nonloaded Q 2580

Temperature Coefficient of Resonance Frequency τ_f 1080 (ppm/°C)

The dielectric material (1) (PbZrO₃-CeO₂ dielectric material) is processed into a cylindrical shape with a diameter of 8.5 mm and a height of 2.8 mm and the dielectric material (2) (SrTiO₃-NiO-Nb₂O₅ dielectric material) is processed into a ring shape with an outer diameter of 10.0 mm, an inner diameter of 8.5 mm and a height of 2.8 mm. Further, the dielectric materials (1) and (2) are compounded and integrated, as shown in Figure 1.

® 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

⑩ 公開実用新案公報(U) 昭63-10603

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)1月23日

H 01 P 7/10

6749-5J

審査請求 未請求 (全 頁)

誘電体共振器 ❷考案の名称

> 昭61-102650 ②実

顧 昭61(1986)7月3日 多出

砂考

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社内

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニー株式会社 砂出 願 人

外1名 砂代 理 人 弁理士 小 池 晃

明細書

考案の名称
誘電体共振器

2. 実用新案登録請求の範囲

共振周波数の温度係数が正負異なる極性の誘電体材料を組み合わせてなる誘電体共振器であって、第1の極性の温度係数を有する誘電体材料を囲んで同心円状に第2の極性の温度係数を有する誘電体材料を組み合わせたことを特徴とする誘電体共振器。

3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は、マイクロ波帯域で使用される誘電体 共振器に関するものであり、特に2種類の誘電体 材料を組み合わせた誘電体共振器の改良に関する ものである。

(考案の概要)

本考案は、共振周波数の温度係数が正負異なる 極性の誘電体材料を組み合わせてなる誘電体共振 器において、第1の極性の温度係数を有する誘電 体材料を囲んで同心円状に第2の極性の温度係数 を有する誘電体材料を組み合わせることにより、

温度特性を所定の値に保ったままで簡単に共振 周波数の調整を行うことができる誘電体共振器を 提供しようとするものである。

(従来の技術)

誘電体磁器は、マイクロ波領域においても、例えばマイクロ波回路の誘電体共振器,インピータンス整合用素子,マイクロ波集積回路(マイクロ波して)の基板等に用いられており、特に発器の同波数安定化やフィルター等に利用される誘電体共振器がマイクロ波回路の小型化に貢献している。この誘電体共振器は、誘電体中で波長が1/√€(但しょは誘電率を表す。)に短縮されることを利用したものであり、したがって使用する誘電体材料の誘電率が大きいほど小型化に有利

である。

ところで、従来よりSrTiO₃-CaTiO₃-CaSiTiO₃系 誘電体材料の如き誘電率の極めて高い誘電体材料 が開発されているが、この種の材料は誘電率の温 度特性がマイナス側に大きく(したがって共振周 波数の温度特性はプラス側に大きい。)、そのま ま誘電体共振器に使用するには不適当である。

そこで、これまで共振周波数の温度係数が正負異なる2種類の誘電体材料を組み合わせて温度係数の小さな誘電体共振器を得る試みがなされている。すなわち、第3図に示すように、正負異なる極性を有する誘電体材料をそれぞれ円板状に加工し、これら円板状誘電体(11)、(12)を上下に貼り合わせて温度特性の偏りを解消することが試みられている。

(考案が解決しようとする問題点)

しかしながら、上述のように円板状誘電体(11)。 (12) を上下に貼り合わせた誘電体共振器(10)で は、次のような問題が生じていた。

すなわち、円柱状の誘電体共振器(10)の共振周 波数は、当該誘電体共振器(10)の直径 D と高さし の比率によって決まる。一方、円板状誘電体(11)。 (12)の複合体からなる誘電体共振器(10)の共振 周波数の温度係数は、誘電体(11)と誘電体(12)の 体積比により決まる。したがって、この誘電体 振器(10)の温度係数を変えずに共振周波数を調整 するには、誘電体(11)と誘電体(12)の体積比を一定に保ちながら高さしを調整することが必要となる。 実際には、円柱状の誘電体共振器(10)の上下 両でに変がしい技術を要求されるとともに、 産性にも欠けるものとなる。

そこで本考案は、上述の従来のものの有する欠点を解消するために提案されたものであって、共振周波数とその温度特性の調整が独立に、しかも容易に行える誘電体共振器を提供することを目的とし、特性に優れ生産性にも優れた誘電体共振器を提供することを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

上述の目的を達成するために、本考案は共振周 被数の温度係数が正負異なる極性の誘電体材料を 組み合わせてなる誘電体共振器であって、第1の 極性の温度係数を有する誘電体材料を囲んで同心 円状に第2の極性の温度係数を有する誘電体材料 を組み合わせたことを特徴とするものである。

(作用)

本考案の誘電体共振器では、互いに異なる極性 の誘電体材料を同心円状に配置しているので、円 柱の高さを変えても組み合わされる誘電体材料の 体積比は変わらない。

したがって、誘電体共振器の温度特性と共振周 波数は独立に制御されることになる。

(実施例)

以下、本考案の具体的な実施例について詳細に 説明する。

本考案の誘電体共振器は、円柱状あるいはリン

グ状の誘電体共振器であって、共振周波数の温度 係数が正負異なる極性を有する誘電体材料を同心 円状に組み合わせたものである。

すなわち、例えば第1図に示すように、共振周波数の温度係数が第1の極性(例えばマイナス)の誘電体材料(1)を円柱状に成形するとともに、その周囲を囲む如く第2の極性(例えばプラス)の温度係数を有する誘電体材料(2)をリング状に配置することにより構成される。

あるいは、第2図に示すように、中心部の誘電体材料(1) もリング状に形成し、全体としてリング状の誘電体共振器とすることも可能である。

ここで、共振周波数の温度特性で、がプラスの誘電体材料としては、従来より知られている誘電体材料の多くが相当し、例示するならばSrTiO。系誘電体材料等が挙げられる。

一方、共振周波数の温度特性で、がマイナスの 誘電体材料としては、例えばPbZrO3にTb4O7, CeO2. TeOz, Gd2O3, Dy2O3を添加したもの等が使用可能で ある。 これら誘電体材料のなかから誘電体材料(1)及び誘電体材料(2)を選択し、共振周波数の温度係数 r, が最も小さくなるような体積比で組み合わせればよい。

実際、本考案者が誘電体材料を選択して誘電体 共振器を作成したところ、次のような結果が得ら れた。

先ず、共振周波数の温度特性の極性が正負異なる誘電体材料として、PbZr0g-Ce02系誘電体材料及びSrTiOg-NiO-Nb2Os系誘電体材料を選び、これらをそれぞれ誘電体材料(1)、誘電体材料(2)として第1図に示すのと同様の誘電体共振器を作成した。以下に使用した誘電体材料の3GHzでの特性を示す。

A: PbZrO3-CeO2 系誘電体材料

誘電率 Er

1 3 9

無負荷Q

7 0 0

共振周波数の温度係数で。-1070(ppm/℃)

B:SrTiO3-NiO-Nb2Os系誘電体材料

誘電率モデ

2 1 3

無負荷Q

2 5 8 0

共振周波数の温度係数で、1080(ppm/で)なお、誘電体材料(1)(PbZrOg-CcO2 系誘電体材料)は直径8.5 mm,高さ2.8 mmの円柱状に、誘電体材料(2)(SrTiOg-NiO-Nb2Og系誘電体材料)は外径10.0 mm,内径8.5 mm,高さ2.8 mmのリング状に加工し、第1図に示すように複合一体化した。

得られた誘電体共振器の 3 G Hz における特性は、誘電率 ϵ 、 = 159 、 無負荷 Q = 1160 、 共振 周波数の温度係数 τ 、 = 80 (ppm/\mathbb{C}) となり、温度特性 (τ 、) が補償された誘電体共振器を得ることができた。 当然ながら、この時の温度特性 (τ 、) の値は、誘電体材料(1) と誘電体材料(2) の体積比を変えることによって調整することかできる。

一方、この誘電体共振器の高さHを変えることによって、先の温度係数 (r r) の補償を損なうことなく共振周波数のみを調整することができた。このときの高さHと共振周波数 f 。との関係は、通常の誘電体共振器における関係、すなわち

「。 ≒ 1 3 8 / (H √ 1 + 1. 2 9 ε r) と同様で あった。

〔考案の効果〕

以上の説明からも明らかなように、本考案の誘電体共振器は共振周波数の温度特性がプラスの誘電体材料とマイナスの誘電体材料を同心円状に組み合わせているので、共振周波数とその温度特性を独立に制御することができ、単に円柱の高さを変えることで温度特性を一定に保ったまま共振周波数の調整を行うことができる。

また、前述のように共振周波数等の調整が容易であるため、特性に優れた誘電体共振器を低コストで大量に作製することが可能となり、生産性に優れた誘電体共振器とすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本考案を適用した誘電体共振器の一例 を示す概略的な斜視図であり、第2図は本考案を 適用した誘電体共振器の他の例を示す概略的な斜

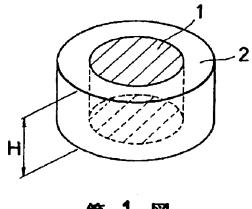
視図である。

第3図は従来の誘電体共振器の一例を示す概略 的な斜視図である。

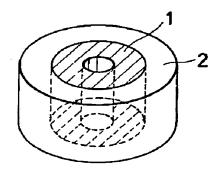
1・・・誘電体材料 (第1の極性)

2 · · · 誘電体材料 (第2の極性)

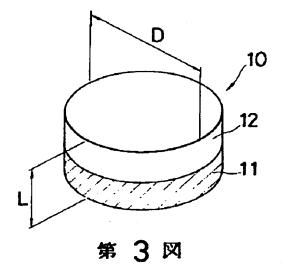
実用新案登録出願人 ソニー株式会社 代理人 弁理士 小池 晃 同 田村祭一



第 1 図



第 2 図



式 会 社 (他一名)

27